MgO スパッタ薄膜の表面ラフネスの膜厚変化

村山 直弥 薄膜•表面物性研究室 T015070 Naoya Murayama

目的

酸化マグネシウム(MgO)は、耐スパッタ性に優れ、二次電子放出係数が高い、絶縁体で透 明であるなどの特徴がある。これらの特徴はプラズマディスプレイパネルの電極保護材に適 していて、実際に使用されている。しかしながら、MgO は作製方法によって性質が大きく 異なることが報告されている。 また表面ラフネスは電子放出にも影響を及ぼすと考えられ、 過去の実験では、表面ラフネスは圧力に依存していることが報告されている。今回の研究で は原子間力顕微鏡(AFM)を用いて MgO 薄膜のラフネスと膜厚の関係を調べた。

実験

MgO薄膜はRFスパッタ装置を用いて反応性スパッタリン グによって作製した。8cm のMgOターゲットに高周波電力 100 W(13.56 MHz)を加え、Ar流量を 8 sccm、O2流量を 2 sccmとして製膜した。基板はシリコンの鏡面を用い、全圧 力:2、10 Pa、膜厚:100、150、200、300 nmという条件 で製膜した。作製したMgO薄膜はAFMを用いて表面の形状 を観察した。AFMの探針としては、膜表面の帯電を避けるた めに良導体のSiのチップを使用した。

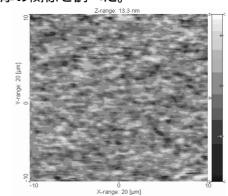


図 1 MgO 表面の AFM 像 (10 Pa 200 nm)

結果・考察

図 1 のような $20 \times 20 \mu$ m²のAFM画像より平均自乗ラフネスw(L) を算出した(図 1 でのz スケールは 13.3 nm)。観測スケール $L=0.13\sim17\,\mu$ mの範囲でスケーリング性を調べた結果 を図 2, 3 に示す。まず、スケール 1 μ m以下ではMgO膜表面はフラクタル的な特徴を持って いることがわかる。また、どのスケール領域においても、膜厚の増加に伴ってラフネスは増 加している。AFM画像を比較すると、膜厚とともに粒径がz軸方向に大きくなり不均一にな るように見えた。一方、スパッタ圧力の効果としては高圧力の方が表面ラフネスが小さくな る結果が得られ、これまでの経験と逆の結果となった。今回の実験も 1 時間のプレスパッタ など標準的な手順を経て製膜してきたが、結果的にラフネスと強い因果関係をもっていたの は、スパッタ装置の使用履歴であった。

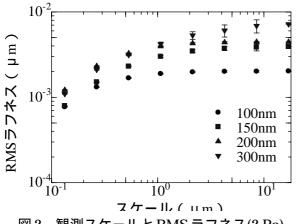


図2 観測スケールと RMS ラフネス(2 Pa)

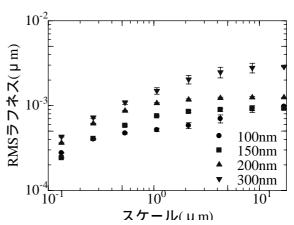


図3 観測スケールと RMS ラフネス(10 Pa)